

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4900DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI4900DY-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	SI4900DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 4.3A, 10V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4900DY-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	665pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 5.3A 3.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A
Basisteilenummer	SI4900

SI4900DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4900DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4900DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4900DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4902DY VISHAY SI4902DY VISHAY</p>	 <p>SI4900DY SI SI4900DY SI</p>	 <p>SI4902DY-T1 VISHAY SI4902DY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4898DY-T1-E3 VISHAY SI4898DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI4900DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC</p>	 <p>SI4901-B-GL SILICON SI4901-B-GL SILICON</p>	 <p>SI4900DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC</p>	 <p>SI4900DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4900DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4900DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4900DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4900DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4900DY-T1-GE3
SI4900DY-T1-GE3 Electronic	SI4900DY-T1-GE3-Komponenten	SI4900DY-T1-GE3-Verteiler	SI4900DY-T1-GE3-Bild	SI4900DY-T1-GE3-Teil
SI4900DY-T1-GE3 Preis	SI4900DY-T1-GE3 Hersteller	SI4900DY-T1-GE3 Bild	SI4900DY-T1-GE3 Aktie	SI4900DY-T1-GE3 Inventar
SI4900DY-T1-GE3 Neu	SI4900DY-T1-GE3 Original	SI4900DY-T1-GE3 garantiert	SI4900DY-T1-GE3 RFQ	SI4900DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited